直流マグネトロンスパッタ法による多結晶 Al 添加 ZnO 透明導電膜 における配向秩序制御

The controllable crystallographic orientation of polycrystalline transparent conductive

Al-doped ZnO films deposited by direct current magnetron sputtering



高知工科大総研¹、住友重機械工業株式会社²、高輝度光科学研究センター³

[°]野本淳一¹、北見尚久^{1,2)}、渡辺剛³、牧野久雄¹、酒見俊之²、山本哲也¹

Research Inst. Kochi Univ. Tech.¹, Sumitomo Heavy Industries, Ltd.², Japan Synchrotron Radiation Research Inst. (JASRI) SPring-8³ °J. Nomoto¹, H. Kitami^{1,2}, T. Watanabe³, H. Makino¹, T. Sakemi², T. Yamamoto¹

E-mail: nomoto.junichi@kochi-tech.ac.jp

【はじめに】 多結晶 Al 添加 ZnO (AZO) 透明導電膜におけるキャリア輸送機構の支配因子を検 討している。現時点で、主要なキャリア輸送阻害因子は、(0001) 配向以外の配向 (例えば、(10-11)) の残存であるといった結論に至っている。解決策として、直流アーク放電を用いるイオンプレー ティングで成膜した Ga 添加 ZnO 極薄膜(膜厚 10 nm、以下、CL (Critical Layer) と呼称)の 挿入を提案している¹⁻²⁾。本研究では、CL の配向制御効果を明白にするべく、前記 (0001) 配向 以外の配向出現の膜厚依存性の観点から検討した。

【実験方法】 膜厚 10-200 nm の AZO 膜を、*CL* 有無の2つの場合で成膜した。基板は、200 ℃ に加熱されたガラス基板 (Corning, EAGLE-XG) を用い、ターゲットは ZnO に Al₂O₃ を 0.5 wt.% 混合した円形高密度焼結体を使用した。成膜法は、直流マグネトロンスパッタ法である。 柱状結晶子の配向特性は、入射 X 線として、放射光 (12.40 keV)) 及び 2 次元検出器 (PIRATUS 300K) を用いるすれすれ入射 (GI-) 高角 X 線散乱 (WAXS) 法 (SPring-8 ビームライン : BL19B2) により測定し、解析した。

【結果と考察】 議論の対象である (0001) 配向以外の配向組織は膜厚 50 nm から出現すること が GI-WAXS 法により測定した 2 次元回折像により明白となった。図 1 は、*CL* が (a) 無し、 及び (b) 有りの場合の AZO 膜における 2 次元回折像の膜厚依存性を示す。同図中の q_z 軸及 び q_{xy} 軸は、それぞれ積層及び面内方向を示す。解析の結果、*CL* の有無に関わらず、(0001) 配 向に起因する 10-12、10-11 及び 10-10 反射が、膜成長初期から確認された。*CL* 付きの AZO 膜 (図 1 (b)) では、膜成長初期からバルクに至るまで、(0001) 配向のみであることが明白となった。 一方、*CL* 無しの AZO 膜 (図 1 (a)) では、上記の 3 つの反射以外に、(0001) 配向度が低いこと を示す 0002 反射が q_z 軸上に観察された。*CL* 有りの場合と大きく異なる点は、膜厚が 50 nm よりも厚くなると (10-11) 配向に起因する 0002、10-11、10-10 反射が観察されることにある。 X 線回折法により評価した格子定数に対する解析を基に、AZO バルク層の構造特性を決める支 配因子について、更に議論する。

【謝辞】 GI-WAXS 測定は SPring-8 課題番号 2016B1588 のもとに行われた。【参考文献】 1) J. Nomoto et al., *Nanoscale Res. Lett.*, **11**, 320 (2016). 2) J. Nomoto et al., *Thin Solid Films*, **620**, 2 (2016).

